



汕头华汕电子器件有限公司

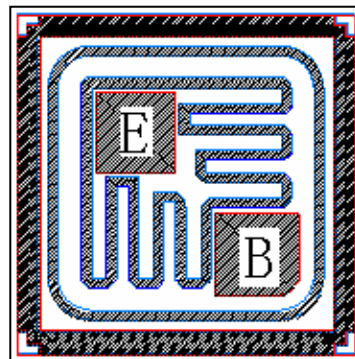
NPN SILICON TRANSISTOR

9013 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：C043BJ-00
芯片厚度：240±20μm
管芯尺寸：430×430μm²
焊位尺寸：B 极 107×107μm²，E 极 101×101μm²
电极金属：铝
背面金属：金
典型封装：SS9013，H9013，8050S

管芯示意图



极限值（T_a=25℃）（封装形式：TO-92）

T_{stg}——贮存温度…………… -55~150℃
T_j——结温……………150℃
P_C——集电极耗散功率……………625mW
V_{CBO}——集电极—基极电压……………40V
V_{CEO}——集电极—发射极电压……………20V
V_{EBO}——发射极—基极电压……………5V
I_C——集电极电流……………500mA

电参数（T_a=25℃）（封装形式：TO-92）

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			0.1	μA	V _{CB} =25V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			0.1	μA	V _{EB} =3V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	80		390		V _{CE} =1V, I _C =50mA
		40				V _{CE} =1V, I _C =500mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			0.6	V	I _C =500mA, I _B =50mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			1.2	V	I _C =500mA, I _B =50mA
V _{BE(on)}	基极—发射极导通电压	0.6		0.73	V	V _{CE} =1V, I _C =10mA
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	40			V	I _C =100μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	20			V	I _C =1mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	5			V	I _E =100μA, I _C =0